



行业动态
Industry News



三星首家量产40nm级工艺4GbDDR3绿色内存芯片

2010-02-26 | 编辑: | 【大】 【中】 【小】 【打印】 【关闭】

三星电子宣布, 该公司已经在业内第一家使用40nm级别工艺批量生产低功耗的4GbDDR3内存芯片。

这种内存芯片支持1.5V和1.35V两种工作电压, 可组装成16/32GBRDIMM服务器内存条或者8GBSO-DIMM笔记本内存条, 性能1.6Gbps, 功耗相比于上一代产品降低35%, 能为数据中心、服务器系统或者高端笔记本节省大量能源。

三星指出, 目前服务器系统平均每路处理器搭配六条RDIMM内存条, 总容量最大96GB, 如果是60nm1GbDDR2芯片, 内存子系统功耗可达210W, 换成40nm2GbDDR3芯片就只消耗55W, 而最新的40nm4GbDDR3会进一步降至仅仅36W, 也就是节能83%之多, 相当于为每套服务器系统节约10%的功耗。

由于单颗芯片容量翻番, 4GbDDR3芯片的量产也能大大推动单条32GB内存条的普及。

三星从去年七月开始引入40nm级别的DDRDRAM生产工艺, 并计划将该工艺的生产比例逐渐提高到90%以上。

(来源: 驱动之家 2010年2月25日)

▣ 科普首页

▣ 微电子历史

▣ 行业动态

▣ 术语解释

▣ 无微不至

▣ 芯片制程

▣ 科普创意